



深圳市大雁科技实业有限公司

Dayan Technology Industry Co., Ltd. Shenzhen



3DD13007

1.主要特点

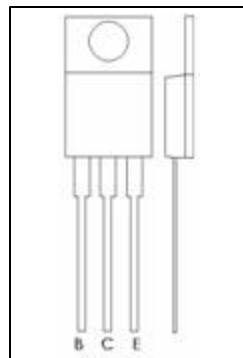
- 硅 NPN 三重扩散平面结构
- 击穿电压高
- 电流容量大
- 开关时间短
- 安全工作区大

2.封装形式 TO-220

3.主要用途

电子镇流器及各类功率开关电路

4.绝对最大额定值 $T_a=25$



项目	符号	数值	单位
集电极—基极直流电压	V_{CBO}	700	V
集电极—发射极直流电压	V_{CEO}	400	V
发射极—基极直流电压	V_{EBO}	9	V
集电极直流电流	I_C	8	A
集电极耗散功率 $T_a=25$	P_C	3.0	W
$T_c=25$		100	
最高结温	T_j	150	
贮存温度范围	T_{stg}	-55~150	

5 电特性 $T_a=25$

项目	符号	测试条件	规范		单位
			Mi n	Ma x	
集电极—基极直流电压	BV_{CBO}	$I_C=1mA$ $I_E=0$	700		V
集电极—发射极直流电压	BV_{CEO}	$I_C=10mA$ $I_B=0$	400		V
发射极—基极直流电压	BV_{EBO}	$I_E=1mA$ $I_C=0$	9		V
集电极—基极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=680V$ $I_E=0$		5	μA
集电极—发射极截止电流	I_{CEO}	$V_{CE}=390V$ $I_B=0$		5	μA
发射极—基极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=9V$ $I_C=0$		5	μA
集电极—发射极饱和压降	V_{CEsat}	$I_C=2A$ $I_B=0.4A$		1.0	V
		$I_C=8A$ $I_B=2A$		2.5	V
基极—发射极饱和压降	V_{BEsat}	$I_C=5A$ $I_B=1A$		1.8	V
直流电流增益	h_{FE}	$V_{CE}=5V$ $I_C=2A$	15	30	5倍分档
下降时间	t_f	$I_C=0.5A$		0.5	μs
贮存时间	t_s	$I_{B1} = -I_{B2} = 0.1A$		8	μs
特征频率	f_T	$V_{CE}=10V$ $I_C=500mA$ $f=1MHz$	5		MHz

地址：广东省深圳市南山区西丽留仙大道桑泰工业园 1 栋

邮编：518055 -1-

电话：0755-86020755 传真：0755-86020855

网址：<http://www.dayan.com.cn>